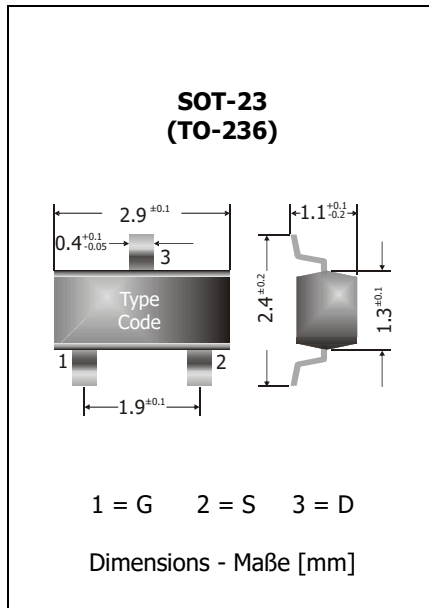


**MMFTP3401**  
**P-Channel Enhancement Mode FET**  
**P-Kanal FET – Anreicherungstyp**

$I_D = -4\text{ A}$        $V_{DS} = -30\text{ V}$   
 $R_{DS(on)} < 65\text{ m}\Omega$        $P_{tot} = 1000\text{ mW}$   
 $T_{jmax} = 150^\circ\text{C}$

Version 2019-09-24

**Typical Applications**

Signal processing, Drivers,  
 Logic level converter  
 Commercial grade <sup>1)</sup>

**Features**

High Drain current  
 Low on state resistance  
 Fast switching times  
 Compliant to RoHS, REACH,  
 Conflict Minerals <sup>1)</sup>

**Mechanical Data <sup>1)</sup>**

Taped and reeled      3000 / 7"  
 Weight approx.      0.01 g  
 Case material      UL 94V-0  
 Solder & assembly conditions      260°C/10s  
 MSL = 1

**Typische Anwendungen**

Signalverarbeitung, Treiberstufen,  
 Logikpegelwandler,  
 Standardausführung <sup>1)</sup>

**Besonderheiten**

Hoher Drain-Strom  
 Niedriger Einschaltwiderstand  
 Schnelle Schaltzeiten  
 Konform zu RoHS, REACH,  
 Konfliktmineralien <sup>1)</sup>

**Mechanische Daten <sup>1)</sup>**

Gegurtet auf Rolle  
 Gewicht ca.  
 Gehäusematerial  
 Löt- und Einbaubedingungen

**Maximum ratings <sup>2)</sup>****Grenzwerte <sup>2)</sup>**

		<b>MMFTP3401</b>	
Drain-Source-voltage Drain-Source-Spannung	- $V_{DS}$	30 V	
Gate-Source-voltage Gate-Source-Spannung	D open $V_{GSO}$	$\pm 12\text{ V}$	
Power dissipation Verlustleistung	$P_{tot}$	500 mW <sup>3)</sup> 1000 mW <sup>4)</sup>	
Drain current Drainstrom	DC      - $I_D$	3 A <sup>3)</sup> 4 A <sup>4)</sup>	
Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur	$T_j$ $T_s$	+150°C -55...+150°C	

**Characteristics****Kennwerte**

		$T_j = 25^\circ\text{C}$		
		<b>Min.</b>	<b>Typ.</b>	<b>Max.</b>
Drain-Source breakdown voltage – Drain-Source-Durchbruchspannung	- $I_D = 250\text{ }\mu\text{A}$	30 V	-	-
	- $V_{(BR)DSS}$			
Drain-Source leakage current – Drain-Source-Leckstrom	- $V_{DS} = 24\text{ V}$	-	-	1 $\mu\text{A}$
	- $I_{DSS}$			

- Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book  
Bitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches
- $T_A = 25^\circ\text{C}$ , unless otherwise specified –  $T_A = 25^\circ\text{C}$ , wenn nicht anders angegeben
- Mounted on P.C. board with 3 mm<sup>2</sup> copper pad at each terminal  
Montage auf Leiterplatte mit 3 mm<sup>2</sup> Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss
- On ceramic substrate – Auf Keramiksubstrat

**Characteristics****Kennwerte**

	$T_j = 25^\circ\text{C}$	<b>Min.</b>	<b>Typ.</b>	<b>Max.</b>
Gate-Source leakage current – Gate-Source-Leckstrom $V_{GS} = \pm 12\text{ V}$	$I_{GSS}$	–	–	$\pm 100\text{ nA}$
Gate-Source threshold voltage – Gate-Source Schwellspannung $V_{GS} = V_{DS} \quad - I_D = 250\text{ }\mu\text{A}$	$-V_{GS(th)}$	0.7 V	–	1.3 V
Drain-Source on-state resistance – Drain-Source Einschaltwiderstand - $V_{GS} = 10\text{ V} \quad - I_D = 4\text{ A}$ - $V_{GS} = 4.5\text{ V} \quad - I_D = 4\text{ A}$ - $V_{GS} = 2.5\text{ V} \quad - I_D = 1\text{ A}$	$R_{DS(on)}$	–	–	65 m $\Omega$ 75 m $\Omega$ 90 m $\Omega$
Forward Transfer Admittance – Übertragungsteilheit - $V_{DS} = 5\text{ V} \quad - I_D = 4\text{ A}$	$g_{fs1}$	7 S	–	–
Input Capacitance – Eingangskapazität - $V_{DS} = 0\text{ V} \quad f = 1\text{ MHz}$	$C_{iss}$	–	–	954 pF
Output Capacitance – Ausgangskapazität - $V_{DS} = 0\text{ V} \quad f = 1\text{ MHz}$	$C_{oss}$	–	–	115 pF
Reverse Transfer Capacitance – Rückwirkungskapazität - $V_{DS} = 0\text{ V} \quad f = 1\text{ MHz}$	$C_{rss}$	–	–	77 pF
Turn-On Delay Time – Einschaltverzögerung - $V_{DD} = 15\text{ V} \quad R = 3.6\text{ }\Omega \quad - V_{GS} = 10\text{ V} \quad R_G = 6\text{ }\Omega$	$t_{d(on)}$	–	6.3 ns	–
Turn-On Time – Anstiegszeit - $V_{DD} = 15\text{ V} \quad R = 3.6\text{ }\Omega \quad - V_{GS} = 10\text{ V} \quad R_G = 6\text{ }\Omega$	$t_{(on)}$	–	3.2 ns	–
Turn-Off Delay Time – Ausschaltverzögerung - $V_{DD} = 15\text{ V} \quad R = 3.6\text{ }\Omega \quad - V_{GS} = 10\text{ V} \quad R_G = 6\text{ }\Omega$	$t_{d(off)}$	–	38 ns	–
Turn-Off Time – Abfallzeit - $V_{DD} = 15\text{ V} \quad R = 3.6\text{ }\Omega \quad - V_{GS} = 10\text{ V} \quad R_G = 6\text{ }\Omega$	$t_{(off)}$	–	7 ns	–
Thermal resistance junction to ambient Wärmewiderstand Sperrschicht – Umgebung	$R_{thA}$	< 250 K/W <sup>1)</sup>		

**Disclaimer:** See data book page 2 or [website](#)  
**Haftungsausschluss:** Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

1 Mounted on P.C. board with 3 mm<sup>2</sup> copper pad at each terminal  
Montage auf Leiterplatte mit 3 mm<sup>2</sup> Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [MOSFET](#) category:*

*Click to view products by [Diodec](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[614233C](#) [648584F](#) [MCH3443-TL-E](#) [MCH6422-TL-E](#) [FDPF9N50NZ](#) [FW216A-TL-2W](#) [FW231A-TL-E](#) [APT5010JVR](#) [NTNS3A92PZT5G](#)  
[IRF100S201](#) [JANTX2N5237](#) [2SK2464-TL-E](#) [2SK3818-DL-E](#) [FCA20N60\\_F109](#) [FDZ595PZ](#) [STD6600NT4G](#) [FSS804-TL-E](#) [2SJ277-DL-E](#)  
[2SK1691-DL-E](#) [2SK2545\(Q,T\)](#) [D2294UK](#) [405094E](#) [423220D](#) [MCH6646-TL-E](#) [TPCC8103,L1Q\(CM](#) [367-8430-0972-503](#) [VN1206L](#)  
[424134F](#) [026935X](#) [051075F](#) [SBVS138LT1G](#) [614234A](#) [715780A](#) [NTNS3166NZT5G](#) [751625C](#) [873612G](#) [IRF7380TRHR](#)  
[IPS70R2K0CEAKMA1](#) [RJK60S3DPP-E0#T2](#) [RJK60S5DPK-M0#T0](#) [APT5010JVFR](#) [APT12031JFLL](#) [APT12040JVR](#) [DMN3404LQ-7](#)  
[NTE6400](#) [JANTX2N6796U](#) [JANTX2N6784U](#) [JANTXV2N5416U4](#) [SQM110N05-06L-GE3](#) [SIHF35N60E-GE3](#)